

SJ

中华人民共和国电子工业部部标准

SJ 2215.1 ~ 2215.14-82

半导体光耦合器测试方法

1982-11-30 发布

1983-07-01 实施

中华人民共和国电子工业部 批准

目 录

SJ 2215.1-82	半导体光耦合器测试方法总则.....	(1)
SJ 2215.2-82	半导体光耦合器(二极管)正向压降的测试方法.....	(2)
SJ 2215.3-82	半导体光耦合器(二极管)正向电流的测试方法.....	(3)
SJ 2215.4-82	半导体光耦合器(二极管)反向电流的测试方法.....	(4)
SJ 2215.5-82	半导体光耦合器(二极管)反向击穿电压的测试方法.....	(5)
SJ 2215.6-82	半导体光耦合器(二极管)结电容的测试方法.....	(6)
SJ 2215.7-82	半导体光耦合器集电极 发射极反向击穿电压的测试方法.....	(7)
SJ 2215.8-82	半导体光耦合器输出饱和压降的测试方法.....	(8)
SJ 2215.9-82	半导体光耦合器(三极管)反向截止电流的测试方法.....	(9)
SJ 2215.10-82	半导体光耦合器直流电流传输比的测试方法.....	(10)
SJ 2215.11-82	半导体光耦合器脉冲上升、下降、延迟、贮存时间的测试方法.....	(11)
SJ 2215.12-82	半导体光耦合器入出间隔离电容的测试方法.....	(13)
SJ 2215.13-82	半导体光耦合器入出间绝缘电阻的测试方法.....	(14)
SJ 2215.14-82	半导体光耦合器入出间绝缘耐压的测试方法.....	(15)